

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 10 月 2 日(02.10.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/156497 A1

- (51) 国際特許分類:
C04B 35/04 (2006.01) G11B 5/82 (2006.01)
C04B 35/46 (2006.01) G11B 5/84 (2006.01)
C23C 14/34 (2006.01) G11B 5/851 (2006.01)
G11B 5/65 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/055346
- (22) 国際出願日: 2014 年 3 月 4 日(04.03.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-073239 2013 年 3 月 29 日(29.03.2013) JP
- (71) 出願人: J X 日鉱日石金属株式会社(JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 高見 英生(TAKAMI Hideo); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 日

鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP). 中村 祐一郎(NAKAMURA Yuichiro); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP). 荒川 篤俊(ARAKAWA Atsutoshi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP). 荻野 真一(OGINO Shin-ichi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).

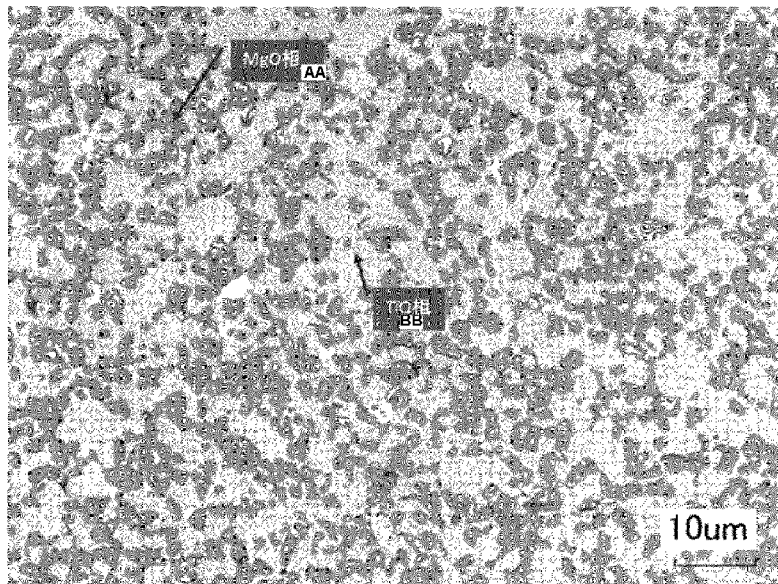
(74) 代理人: 小越 勇, 外(OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 9 番 1 4 号 発明会館 5 階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,

[続葉有]

(54) Title: MGO-TIO SINTERED COMPACT TARGET AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: MgO-TiO 焼結体ターゲット及びその製造方法



AA MgO phase
BB TiO phase

(57) Abstract: A MgO-TiO sintered compact comprising 25 to 90 mol% of TiO₂, with the remainder made up by MgO and unavoidable impurities. The present invention addresses the problem of providing: a highly dense target which has a high film deposition speed and can be subjected to direct-current (DC) sputtering by which particles are formed in a reduced amount; and a method for producing the target.

(57) 要約: TiO₂を25~90mol%含有し、残部がMgO及び不可避免の不純物からなるMgO-TiO焼結体。本発明は、成膜速度が速く、パーティクルの発生が少ない直流(DC)スパッタリングが可能な高密度のターゲット及びその製造方法を提供することを課題とする。

WO 2014/156497 A1



MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ

パ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))